

El iP2010 y el iP2011 integran un CI controlador PowIRtune™ muy avanzado y ultrarrápido, adaptado a un dispositivo de potencia monolítico de conmutación múltiple y basado en GaN. Estos dispositivos están montados sobre una plataforma de encapsulado en micropastilla (flip chip) para lograr una mayor eficiencia y más del doble de la frecuencia de conmutación de los dispositivos integrados de silicio más avanzados para etapa de potencia.



[www.irf.com](http://www.irf.com)

### IR Presenta los Primeros Dispositivos Integrados para Etapa de Potencia iP2010 e iP2011 de GaN Disponibles Comercialmente

Utilizan la Revolucionaria Plataforma Tecnológica GaNpowIR™ de IR, Basada en GaN.

International Rectifier, IR® (NYSE: IRF), un líder mundial en la tecnología de gestión de potencia, ha presentado hoy la primera familia de productos integrados para etapa de potencia disponibles comercialmente que utilizan la revolucionaria plataforma tecnológica para dispositivos de potencia de IR basada en Nitruro de Galio (GaN). La familia de dispositivos iP2010 e iP2011 está diseñada para aplicaciones multifase y en el punto de carga (point-of-load, POL), entre ellas servidores, enrutadores, conmutadores y convertidores CC/CC POL de aplicación general.

“La introducción de esta familia de dispositivos de potencia basados en GaN para aplicaciones CC/CC anuncia una nueva era para las soluciones de conversión de potencia de alta frecuencia, alta densidad y alta eficiencia, y reafirma la posición de IR a la vanguardia del diseño innovador de gestión de potencia”, señaló Goran Stojic, director ejecutivo para Productos POL de la Unidad de Negocio de Potencia para Empresas de IR.

John Lambert, jefe de productos POL, añadió: “Con una capacidad de conmutación de hasta 5MHz, la familia iP201x permite que los diseñadores reduzcan enormemente el valor y el tamaño de los condensadores e inductores de salida cuando el espacio sea escaso. Los dispositivos también se pueden configurar para trabajar a una frecuencia de conmutación más baja en aplicaciones que requieran las eficiencias más elevadas posibles”.

El iP2010 se caracteriza por un rango de tensiones de entrada de 7V a 13,2V y un rango de tensiones de salida de 0,6V a 5,5V con una corriente de salida de hasta 30A. El dispositivo trabaja hasta 3MHz. Trabajando hasta 5MHz,

el iP2011 con patillas compatibles se caracteriza por el mismo rango de tensiones de entrada y salida, pero está optimizado para una corriente de salida de hasta 20A. Al ofrecer dispositivos con múltiples valores de corriente en una huella común, IR proporciona flexibilidad para cumplir diferentes requisitos del cliente en cuanto a nivel de corriente, prestaciones y coste.

Ambos dispositivos, disponibles en un encapsulado LGA con huella reducida, están optimizados para unas pérdidas de potencia muy bajas, se caracterizan por una refrigeración de alta eficiencia de doble cara y son conformes a RoHS.

Las hojas de datos resumidas en una página están disponibles en la web de International Rectifier [www.irf.com](http://www.irf.com). Las hojas de datos completas, las tarjetas de demostración y las muestras están disponibles para clientes cualificados. Contacte con John Lambert en [jlamber1@irf.com](mailto:jlamber1@irf.com).

Arrow Iberia,  
[www.arrowiberia.com/](http://www.arrowiberia.com/)

Farnell  
<http://uk.farnell.com/international-rectifier/>

Silica (Avnet Iberia S.A.U.)  
[www.silica.com](http://www.silica.com)

**Ref. Nº 1004513**